PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-291216

(43) Date of publication of application: 22.11.1989

(51)Int.Cl.

G02F 1/133

G09G 3/36

(21)Application number : 63-120514

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.05.1988

(72)Inventor: YAMAGUCHI TADAHISA

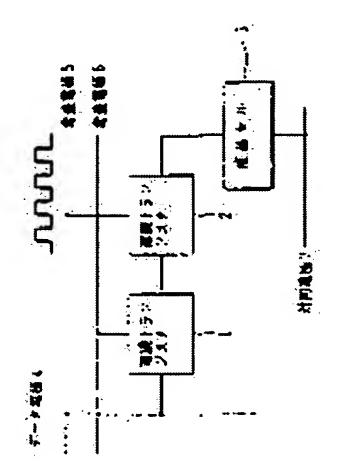
HOSHINO TAKAYUKI TAKAHARA KAZUHIRO

(54) ACTIVE MATRIX TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the deterioration of the drain current-gate voltage characteristics of TFTs from an initial state and to stabilize the contrast of a liquid crystal cell by turning on and off at least one of the two TFTs connected in series with a voltage of about 50% duty ratio.

CONSTITUTION: The TFTs 1, 2 are connected in series. One end of the liquid crystal cell 3 is connected to a counter electrode 7 and the other end to the TFT 2. The TFT 1 is connected to a data electrode 4 and the gates of the TFTs 1, 2 are respectively connected to independent scanning electrodes 5, 6. The voltage set at about 50% duty ratio is impressed to at least either of the electrodes 5, 6. Shifting of the drain current—gate voltage characteristics of the TFTs to a plus direction and shifting thereof to a minus direction are thereby canceled and the drain current—gate voltage characteristics of the TFTs do not change from the initial characteristics. The degradation in the contrast of the liquid crystal cell 3 is obviated.



19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平1-291216

®Int. Cl.⁴

•

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月22日

富士通株式会社

G 02 F 1/133 G 09 G 3/36

3 2 7 7370

7370-2H 8621-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

9発明の名称 アクティブマトリクス型液晶表示装置

②特 願 昭63-120514

20出 願 昭63(1988)5月19日

⑩発明者 山口

忠 久 神奈川県川崎

内

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個発明者 星屋

隆之

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩発明者 高原

和博

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 青 木 朗 外4名

明 細

1. 発明の名称

アクティブマトリクス型液晶表示装置

2. 特許請求の範囲

データ電極とその対向電極との間に液晶を介在させて液晶セルを形成し、このデータ電極に与えられたデータをスイッチング素子を介して前記液晶セルに書き込むアクティブマトリクス型液晶表示装置において、

前記スイッチング素子を、直列接続された2個の薄膜トランジスタで構成すると共に、この2個の薄膜トランジスタのゲートを2本の独立した走査電極に接続し、

少なくとも一方の走査電極の電圧のデューティ 比を約50%にしたことを特徴とするアクティブマ トリクス型液晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概 要〕

データ電極に与えられたデータを、スイッチング素子を介して液晶セルに書き込むアクティブマ

トリクス型液晶表示装置に関し、

前記スイッチング案子の劣化を防止してアクティプマトリクス型液晶表示装置の表示品質を安定・させることを目的とし、

アクティプマトリクス型液晶表示装置のスイッチング素子を、直列接統された2個の薄膜トランジスタで構成すると共に、この2個の薄膜トランジスタのゲートを2本の独立した走査電極に接続し、少なくとも一方の走査電極の電圧のデューティ比を約50%にして液晶セルにデータを書き込むように構成する。

〔産粟上の利用分野〕

本発明はアクティブマトリクス型液晶表示装置 の改良に関する。

近年、アクティブマトリクス駆動方式のフラットディスプレイの研究、開発が盛んに行われている。このアクティブマトリクス駆動方式のフラットディスプレイはブラウン管に比べて奥行を少なくすることができるので、ポケット型テレビやラ

(1)

特開平 1-291216(2)

ップトップ型コンピュータ等の表示器として商品 化もなされている。

ところが、アクティブマトリクス駆動方式では、スイッチング素子として用いられる薄膜トランジスタ、特にアモルファスーシリコン型薄膜トランジスタ(a-SITFT)の特性の劣化により液晶表示装置の表示品質が低下することがあり、この改善が望まれている。

〔従来の技術〕

A. 5

第5図は従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の1素子の構成を示すものである。一般に、従来のアクティブマトリクス型表示装置は、液晶セルが配置された表示層を2つのガラス基板上に変換しており、一方の質を(以下対して変換を)と、液晶セルの一方の質を(以下対向で変換を)が液晶セルの共通電極として形成されて消費といるがある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液晶セルの薄膜にある1つの液面を示すものである。

(3)

交番電圧の周期はテレビ映像におけるラスタスキャンの1垂直走査時間(16.7ms)の2倍である。走査電極5は波形ハで示すように通常0V未満に保持されており、TFT8をオンにする時だけ高い電圧となる。一般にTFT8をオンする時間は60μs となっている。そして、TFT8のオン毎にそのときのデータ電極4のデータが、波形ニで示すように液晶セル3に書き込まれることになる。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、前述のアクティブマトリクス型液晶 表示装置では、TFT8はオン状態よりもオフ状態の方が遙かに長いために、TFT8のドレイン 電流ーゲート電圧特性は、第7図に示すように初 期状態から次第に負側にシフトしていく。する電 TFT8をオフ状態にするためにゲート微小のド レイン電流βが液晶セル3に流れることにかり、 先に液晶セル3に書き込まれたデータ電位が保持 できなくなる。即ち、従来のアクティブマトリク ジスタとの接続および各電極との接続についての み説明する。

アクティブマトリクス型液晶表示装置には第5 図に示すようにデータ電極4、走査電極5及び対向電極7の3本の電極があり、データ電極4と対向電極7との間に1つの液晶セル(LC)3とにの液晶セル3を制御する薄膜トランシスターの液晶セル3を制御するででである。TFTを1の被制御端子の一方に接続されている。また、液温セル3の他方の端子に対向電極7に接続されている。

以上のように構成されたアクティブマトリクス 型液晶表示装置の動作を第 6 図を用いて説明する。

液晶セル3は見掛け上交流バイアスを印加しないと劣化するために、対向電極7は波形イで示すように中間電位に保持され、データ電極4の電圧は波形ロで示すようにこの対向電極7の電位を中心にした交番電圧となっている。データ電極4の

(4)

ス形液晶表示装置には液晶セル3のコントラスト が次第に低下するという課題がある。

なお、前述の現象は、aーSiTFTのゲートに+電圧を印加すると、TFTはオン状態になってドレイン電流が流れるが、蓄積状態の電子がけった絶縁膜/活性暦界面にトラップされていると、TFTはオフ状態になりによるした電流は、10^{-1*A}以下になって、トラップにイン電流は、10^{-1*A}以下になって、トラップにれた電子が放出され、しきい値がマイナス側にシストされるという特性によるものである。

本発明の目的は、アクティブマトリクス型被晶 表示装置に用いられるTFTの経時変化によるし きい値のマイナス方向へのシフトをなくし、アク ティブマトリクス型液晶表示装置の液晶セルのコ ントラストを常に安定させることができるように することにある。

(課題を解決するための手段)

前記目的を達成する本発明のアクティブマトリ

特開平 1-291216(3)

クス型液晶表示装置の構成が第1図に示される。 図において、1、2はTFTであり、これららな 直列に接続されている。3はなしたはは対向電極7に接続され、他端はTFT1に接続されている。まTFT1、2のは アFT2に接続されており、TFT1、2のに ではそれぞれ2本の独立した走査電極5、6の 内にはそれている。そしたではデューティ とも一方にはデューティ とも一方にはデューティ ともれたなられている。 の内にはこれたないる。

〔作 用〕

St. en

(7)

れており、2つのTFT1, 2はそれぞれ独立してオン、オフ制御されるようになっている。

以上のように構成されたアクティブマトリクス 型液晶表示装置の駆動例を第3図を用いて説明する。

液晶セル3は見掛け上交流バイアスを印加しないと劣化するために、対向電極7はこの実施例でも被形向で示すように中間電位に保持され、データ電極4の電圧は波形向で示すようにこの対向電極7の電位を中心にした交番電圧となっている。
対向電極7の交番電圧の周期は、従来装置同様にテレビ映像におけるラスタスキャンの1垂直走査時間 (16.7as) の2倍である。

走査電極 5 には波形(a)で示すように 0 Vを中心にした交番電圧が与えられており、そのデューティ比は50パーセントよりも少し大きくなっている。走査電極 6 には、走査電極 5 の電圧波形(a)と全く同じ周期の波形(a)で示す交番電圧が与えられており、これら 2 つの波形(a)。(b)はラスタスキャンの1 垂直走査時間 (16.7ms) だけ周期がずれている。

い。よって、先に液晶セルに書き込まれたデータ 電位が保持され、液晶セルのコントラストが低下 しない。

(実施例)

以下添付図面を用いて本発明の実施例を詳細に 説明する。

第2図は本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置の一実施例の構成を示すものであるが、この実施例においても表示層にある1つの液晶セルのTFTとの接続および各電極との接続についてのみ説明する。

第2図において、1および2は直列接続された TFT (薄膜トランジスタ)であり、そのソース S1とドレインD2が結合されている。TFT1のドレインD2が結合されている。TFT1のFT 2のソースS2は一端が対向電極7に接続されており、TFT 1のゲートG1と、TFT2のゲートG2とは、それ ぞれ独立した走査電極5及び走査電極6に接続さ

(8)

よって、走査電極5の電圧被形(a)のハイレベル*H*の期間について注目してみると、被形(a)はその立ち上がりから所定時間での間と、立ち下がる直前の同じ時間でだけ、走査電極6のハイレベル*H*の電圧と重なり合い、この期間でだけ第2図のTFT1及びTFT2が共にオンになる。

ところで、従来のアクティブマトリクス型液晶

特開平 1-291216(4)

表示を置では、TFTが組まりもオインは、TFTが組まった。 TFTが間にはないでは、TFTが初期にはないでは、TFTが初期にはないでは、TFTが初期では、TFTがです。 TFTがです。 TFTがです。 TFTができる。 TFTがのです。 TFTがのできる。 TFTがには、TFTがには

よって、TFT1またはTFT2がオフ状態になった時に液晶セル3に微小のドレイン電流は流れないので、液晶セル3のコントラストが低下することがない。

第4図は第2図のアクティブマトリクス型液晶

(11)

電流はTFT2で遮断されるので、液晶セル3のコントラストの劣化が防止される。

なお、第4図における走査電極5と走査電極6 の電圧は入れ換えても全く同じである。

(発明の効果)

40.00

以上説明したように、本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置によれば、直列に接続された2つのTFTの内、少なくとも一方をデューティ比が約50パーセントの電圧でオン/オフするので、TFTのドレイン電流ーゲート電圧特性が初期状態から劣化せず、液晶セル3のコントラストを常に安定させることができるという効果がある。4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置の原理ブロック図、第2図は本発明のアクティブマトリクス型液晶表示装置の一実施例の構成を示す回路図、第3図は第2図の回路の駆動例を示す波形図、第4図は第2図の回路の別の駆動例を示す波形図、第5図は従来のアクティブマ

表示装置の別の駆動例を示すものである。この例では、走査電極 5 に印加する交番電圧は波形向で表 5 に印加する交番電圧を波形向した。 たった 5 に印加する交番電圧を波形向した。 ない 16.7 ms 毎に60 μs だけハイレベル Hs となる 電圧に この例において、 を主電極 5 の波形に している。 従って 電極 6 の波形(向)」との AND 波形は第3図の(f)と同じになる。 12 は第3図の(f)と同じになる。

この実施例の駆動例では、走査電極 6 に接続するTFT1については、オン状態よりもオフ状態の方が遙かに長いために、そのドレイン電流ワート電圧特性は初期状態から次第に負の電位を印加した。TFT1は走査電流が流れ得る状態になるが、TFT2の方はデューティ比が50%の電圧で駆動されているために、そのドレイン電流ーゲートといるために、そのドレイン電流ーゲートといるために、そのドレイン電流ーゲートといるために、そのドレイン電流ーゲートといるために、そのドレイン電流ーゲートといるために、そのドレイン電流ーゲートン

(12)

トリクス型液晶表示装置の構成を示す回路図、第 6 図は第 5 図の回路の駆動波形図、第 7 図は薄膜 トランジスタのドレイン電流-ゲート電圧特性の 初期状態からのシフトを説明する線図である。

- 1, 2, 8…薄膜トランジスタ(TFT)、
- 3…液晶セル、 4…データ電極、
- 5, 6…走查電極、7…対向電極。

特許出顧人 富士通株式会社

特許出願代理人

弁理士 青 木 即

弁理士 石 田 敬

弁理士 平 岩 賢 三 弁理士 山 口 昭 之

弁理士 西 山 雅 也

(13)

14.0第

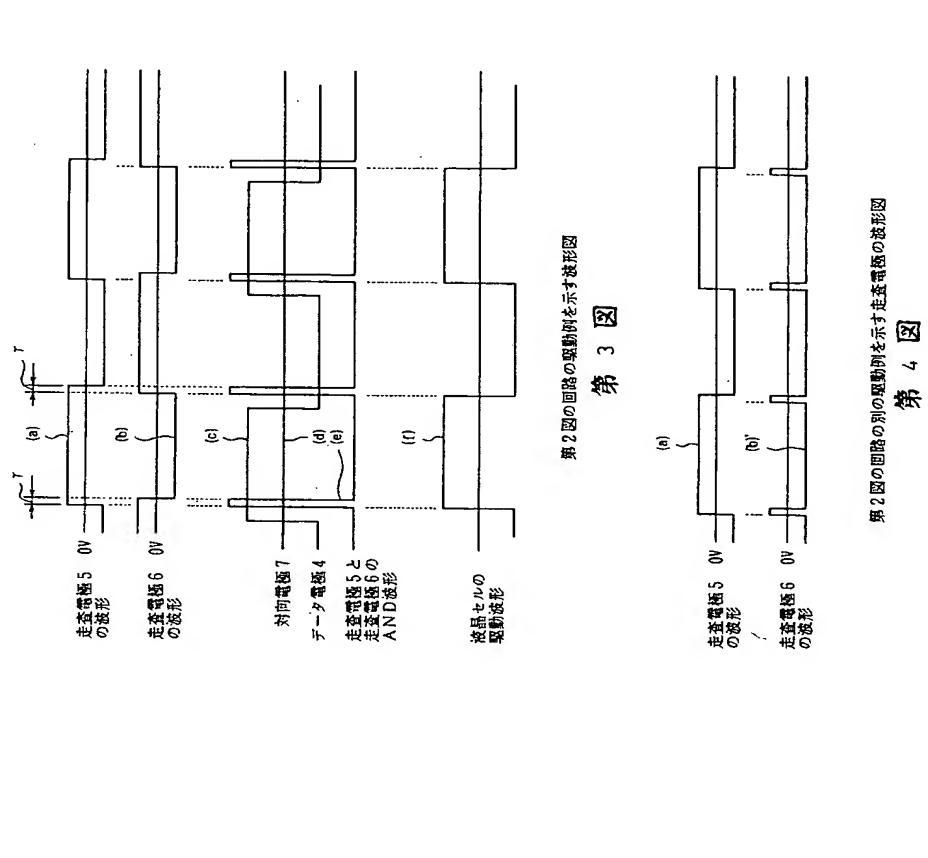
特開平 1-291216(5)

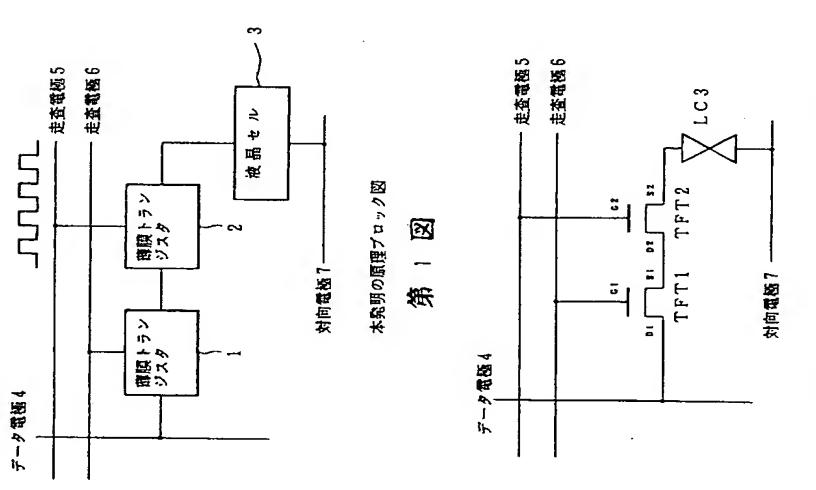
本発明のアクティプマトリクス型液晶表示装置の構成図

X

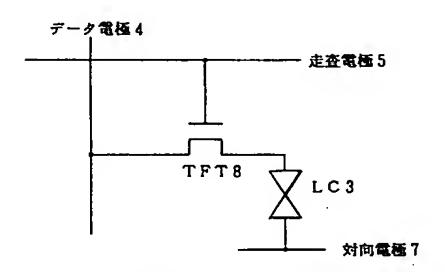
. 2

第



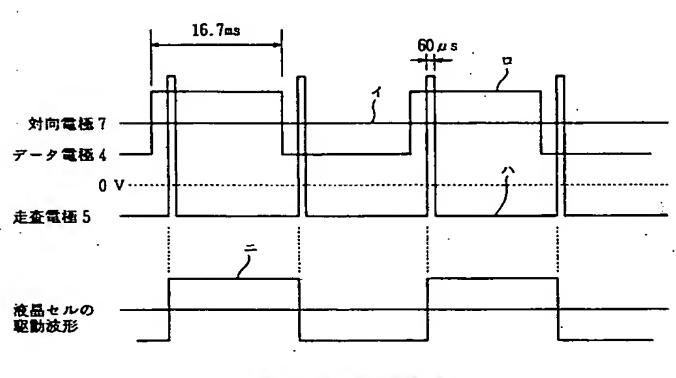


特開平 1-291216(6)

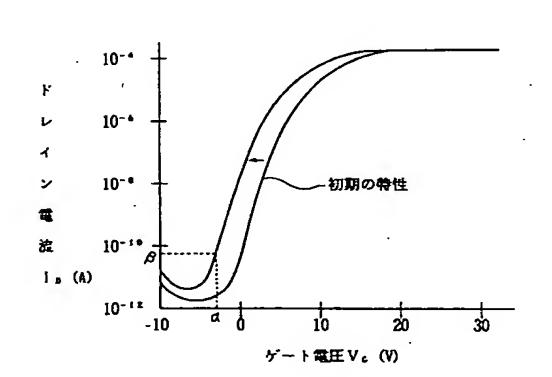


従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の構成図

第 5 図



第5図の回路の駆動放形図第6 図



ドレイン電流ーゲート電圧特性図

第 7 図